

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル  
株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>

E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	SRAM	発行番号	TN-M62-A132A/J	Rev.	第1版
題名	8Mb 低消費電力 SRAM 3V 版:M5M5W816/817 シリーズ、HM62V8100LTTI シリーズの世代交代に関するご連絡		情報分類	製品世代切替	
適用製品	8Mb 低消費電力 SRAM 3V 版: M5M5W816/817 シリーズ、HM62V8100LTTI シリーズ	対象ロット等	関連資料	なし	
		'09/12以降 出荷分			

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では 8Mb 低消費電力 SRAM 3V 版: M5M5W816/817 シリーズ及び HM62V8100LTTI シリーズの世代交代を、以下のスケジュールにて進めさせて頂く予定です。

電气的特性規格、パッケージ寸法規格は上位互換性を有しておりますので、ご協力の程よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

## — 記 —

### 1. 変更内容：8Mb低消費電力 SRAM 3V版: M5M5W816/817 シリーズ及びHM62V8100LTTI シリーズの世代交代

- 8Mb (x8) 3V : HM62V8100LTTI シリーズ から R1LV0808ASB シリーズへ
- 8Mb (x16) 3V : M5M5W816 シリーズ から R1LV0816A シリーズへ
- 8Mb (x8/x16) 3V : M5M5W817KT-70HI から R1LV0816ASD シリーズへ

### 2. 世代交代の概要：チップシュリンクによる世代交代です。0.18μmルール から 0.15μmルールを適用し 更なる生産性向上を図っていきます。

モールド樹脂封止品の外形寸法は従来品と同一であり、置き換えが即可能です。

弊社独自の Advanced Low Power SRAMテクノロジーによる T F T 負荷型のキャパシタセルを用いており 極めて高いソフトエラー耐性を実現しています。

### 3. ご承認に関する資料・評価サンプルのご案内：貴社にご承認・評価頂く為の資料とサンプルは以下の通り準備する予定です。

- データシート : NOW(暫定版)、2009年10月(正式版)
- 動作確認サンプル : 2009年9月
- 信頼度保証サンプル : 2009年11月
- 信頼度資料 : 2009年11月

### 4. 切替え時期 : 2009年12月出荷分より開始

順次世代交代品に切り換えていく予定です。在庫の兼ね合いにより従来製品(M5M5W816/817 シリーズ、HM62V8100LTTI シリーズ)と並行納入されることがありますので、併せてご了承の程、お願ひ致します。

5. 世代交代製品の推奨型名一覧表：

1) 世代交代品の推奨新型名

\*\* 8Mb (x8) 3V 品\*\*

パッケージ	現行型名	推奨新型名
TSOP (II)	HM62V8100LTTI-5	R1LV0808ASB-5SI
	HM62V8100LTTI-5SL	R1LV0808ASB-7SI

\*\* 8Mb (x16) 3V 品\*\*

パッケージ	現行型名	推奨新型名
TSOP(II)	M5M5W816TP-70HI	R1LV0816ASB -7SI
	M5M5W816TP-55HI	R1LV0816ASB -5SI
FBGA	M5M5W816WG-70HI	R1LV0816ABG -7SI
	M5M5W816WG-55HI	R1LV0816ABG -5SI

\*\* 8Mb (x8/x16) 3V 品\*\*

パッケージ	現行型名	推奨新型名
μ TSOP	M5M5W817KT-70HI	R1LV0816ASD-5SI/7SI

2) 新型名の概略



上記対応表が基本となりますが、各製品データシートの電気特性を必ずご査収の上、対応する新形名が合致するかどうかご確認頂けるようお願いいたします。

6. M5M5W816\*\*/817KT, HM62V8100LTTI, R1LV08\*\*A\*\* 比較表

回路	M5M5W816/817 シリーズ	HM62V8100LTTI シリーズ	R1LV08**A シリーズ
メモリセル	Full CMOS 型	Full CMOS 型	TFT 負荷型 キャパシタセル
周辺回路	CMOS	CMOS	CMOS

プロセス	M5M5W816/817 シリーズ	HM62V8100LTTI シリーズ	R1LV08**A シリーズ
ウエハプロセス	1poly, 2metal, 1tungsten	1poly, 3metal	8poly, 2metal, 1tungsten
デザインルール	0.18 μm	0.18 μm	0.15 μm
ゲート酸化膜圧	5.7nm	メモリセル：2.3nm 周辺回路：8nm	6.5 nm
ゲート酸化材質	SiO2	SiO2	SiO2
パシベーション膜厚	0.78 μm	0.6 μm	1.5 μm
パシベーション材質	p-SiN	SiN	HDP, p-SiN

アセンブリ	M5M5W816/817 シリーズ	HM62V8100LTTI シリーズ	R1LV08**ASB シリーズ R1LV0816ASA シリーズ	R1LV08**ASD シリーズ R1LV08**ABG シリーズ
モールド樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂
リードフレーム材質	Fe-Ni 42 alloy	Fe-Ni 42 alloy	Cu	Fe-Ni 42 alloy
リードフレーム処理	Sn/Cu めっき	Sn/Bi めっき	Sn めっき	Sn/Cu めっき
ワイヤボンド材質	Au	Au	Au	Au
ダイボンド材質	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
外部ボール材質 (FBGA)	Sn-Ag-Cu	-	-	Sn-Ag-Cu

パッケージ	HM62V8100LTTI	R1LV0808A*
TSOP II (正ベンド)	○	○

パッケージ	M5M5W816*	R1LV0816A*
TSOP II (正ベンド)	○	○
FBGA	○	○

パッケージ	M5M5W817*	R1LV0816A*
μ TSOP	○	○
TSOP I (正ベンド)	-	○

以上、ご高覧の程よろしくお願い致します。